希塩酸法によって生成された BiOCI の Bi₂Sr₂CaCu₂O_v中の成長メカニズム

Growth mechanism of BiOCl in Bi₂Sr₂CaCu₂O_y made by a dilute hydrochloric acid method 長岡技術科学大学 極限エネルギー密度工学研究センター¹, 電気系², 情報通信研究機構³

^O小瀧 侑央¹, 西方 翼², 川上 彰³, 加藤 孝弘², 安井 寬治², 鈴木 常生¹, 中山 忠親¹, 末松 久幸¹, 新原 晧一¹

Y. Kotaki¹, T. Nishikata², A. Kawakami³, T. Kato², K. Yasui², T. Suzuki¹, T. Nakayama¹, H. Suematu¹ and K.Niihara¹ ¹Extreme Energy-Density Research Institute, Nagaoka University of Technology

²Dept. Elec. Eng., Nagaoka University of Technology

³Advanced ICT Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology

E-mail: *k_yukio@etigo.nagaokaut.ac.jp

Kleiner らによって高温超伝導体 Bi₂Sr₂CaCu₂O_y(Bi-2212)中の固有ジョセフソン効果が発見されて以来[1]、精 力的にジョセフソン接合に関する基礎特性が研究されてきた。中でも 2007 年に Ozyuzer 等は THz 帯電磁波の 放射現象を Bi-2212 固有接合デバイスにおいて発見した。このデバイスは新たな THz 帯の発振器として注目を 集め、多くの研究がなされている。現在までに放射はジョセフソン発振周波数と固有接合スタックを空洞共振 器とした場合の共振周波数が一致した時に生ずると理解されている。また、その放射強度は接合数の二乗に比 例すると報告されている[2]。しかし、発振器として利用するためにはその発振強度の更なる向上が課題とされ る。より強い発振を得るためには接合数が多く Bi-2212 の c 軸方向に面積が一定であるデバイスが必要となる。 その為、緻密なデバイス作製技術が要求される。現在、固有接合スタックは主に物理エッチングによって作製 されており、作製したスタックの端部に照射損傷を受けることが不可避である。

一方、我々はこれまで化学反応を利用した希塩酸法[3]を用いて接合端部に照射損傷が発生しないデバイス作 製法について研究を進めてきた。希塩酸法によって作製されるデバイスの構造をコントロールするためには希 塩酸と Bi-2212 が反応した際に生成される BiOCl の成長メカニズムを明らかにする必要がある。本報告では BiOCl 成長メカニズムを明らかすることを目的として Bi-2212 中の a,c 軸方向における BiOCl の成長速度の観 察を行ったので報告する。

自己フラックス法によって作製された Bi-2212 の単結晶を用いて実験を行った[4]。フォトリソグラフィーを 用いて表面にレジストを塗布・パターニングした Bi-2212 結晶を希塩酸に浸漬させることでデバイスを作製し た。その際、希塩酸濃度、浸漬時間と水溶液温度を変化させ実験を行った。生成した BiOCI の形状を観察する ため集束イオンビーム加工装置(FIB)でデバイスを加工し、走査型電子顕微鏡(SEM)を用いてアンダーカットの 微構造を観察した。観察結果を Bi-2212 の c 軸方向と ab 面内方向それぞれまとめたものを Figs.1 と 2 に示す。 Fig.1 は水溶液温度を横軸に、それぞれの希塩酸濃度の時の Bi-2212 の ab 面内の反応速度定数を縦軸にアレニ ウスプロットしたものである。各希塩酸濃度における結果が線形に乗っていることから BiOCI は Bi-2212 の ab 面内方向には反応律速によって成長することがわかった。Fig.2 は浸漬時間の平方根を横軸に、Bi-2212 の c 軸 方向に生成された BiOCI の深さをプロットしたものである。Fig.2 より生成深さは時間の平方根に比例してい ることがわかった。したがって BiOCI は Bi-2212 の c 軸方向に拡散律速によって成長していることがわかった。



Fig.1 BiOClのab面内方向の反応速度定数



Fig.2 BiOClのc軸方向の生成量の浸漬時間

参考文献 の水溶液温度依存性

依存性

[1] R. Kleiner et al., Phys. Rev. Lett., vol.68 (1992) pp.2394-2397.

[2] L. Ozyuzer et al., Science, vol. 318 (2007) pp.1291-1293.

[3] T. Kato et al., TEION KOGAKU (J. Cryo. Super. Soc. Jpn), vol. 46 No. 8 (2001) pp. 489-494

[4] H. Ishida et al., Physica C, vol.412 (2004) pp.1406-1409.